

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成22年7月8日(2010.7.8)

【公開番号】特開2008-21640(P2008-21640A)

【公開日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【年通号数】公開・登録公報2008-004

【出願番号】特願2007-147170(P2007-147170)

【国際特許分類】

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 5 B 33/12 (2006.01)

H 0 5 B 33/22 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/14 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/12 B

H 0 5 B 33/22 Z

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/14 Z

【手続補正書】

【提出日】平成22年5月25日(2010.5.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、第 1 の電極を形成し、  
 前記基板及び前記第 1 の電極上に、ポリシランを含む絶縁層を形成し、  
 前記絶縁層にモールドを押しつけて加熱し、前記第 1 の電極上の前記絶縁層中に開口部を形成し、  
 前記開口部の形成された絶縁層から、前記モールドを取り外し、  
 前記開口部の形成された絶縁層に UV 光を照射し、その後、加熱して酸化珪素を含む隔壁を形成し、  
 前記第 1 の電極及び前記隔壁上に、発光層を形成し、  
 前記発光層上に、第 2 の電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、  
 前記モールドは、金属材料または絶縁材料により形成されており、  
 前記モールドの表面には凹凸が形成されていることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 において、  
前記モールドを取り外す際に、前記絶縁層に超音波を用いて振動を加えることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一において、

前記モールドを取り外した後、前記開口部の形成された絶縁層の表面を、酸素プラズマを用いて硬質化させることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかーにおいて、

前記絶縁層は、Si-Si 結合及び Si-C 結合を含むポリシランを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかーにおいて、

前記隔壁は、Si-Si 結合、Si-C 結合及び Si-O 結合を含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。